

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

012186224 **Image available**

WPI Acc No: 1998-603137/ **199851**

XRAM Acc No: C98-180580

Mfg. method for monatomic layer carbon nanotube - by laser evaporation process, and dia. of the nanotube is controlled by changing the atmos. temp.

Patent Assignee: MITSUBISHI CHEM CORP (MITU)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 10273308	A	19981013	JP 9793065	A	19970327	199851 B
JP 3365475	B2	20030114	JP 9793065	A	19970327	200308

Priority Applications (No Type Date): JP 9793065 A 19970327

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 10273308	A	6		C01B-031/02	
JP 3365475	B2	6		C01B-031/02	Previous Publ. patent JP 10273308

Abstract (Basic): JP 10273308 A

The carbon nanotube is manufactured by laser evaporation process, and dia. of the nanotube is controlled by changing the atmos. temp.

USE - The carbon nanotube is used for high technological field, e.g. one dimensional wire, and catalyst.

ADVANTAGE - The dia. of the monatomic layer carbon nanotube is controlled.

Dwg. 1/3

Title Terms: MANUFACTURE; METHOD; LAYER; CARBON; LASER; EVAPORATION; PROCESS; DIAMETER; CONTROL; CHANGE; ATMOSPHERE; TEMPERATURE

Derwent Class: E36; F01; J04; L02

International Patent Class (Main): C01B-031/02

International Patent Class (Additional): B01J-019/12; D01F-009/127

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): E05-U02; F01-D09A; J04-E04; L02-H04

Chemical Fragment Codes (M3):

01 G000 G051 M280 M320 M415 M424 M510 M520 M530 M541 M610 M720 M903

M904 N515 Q323 Q451 9851-IX801-K 9851-IX801-P

Generic Compound Numbers: 9851-IX801-K; 9851-IX801-P

【特許請求の範囲】

【請求項1】 カーボンロッドにレーザーを照射する、単原子層カーボンナノチューブのレーザー蒸発法による製造方法において、非照射部のカーボンロッドの雰囲気温度とカーボンナノチューブの径の相関関係に基づき、該雰囲気温度を変えることにより、該ナノチューブの径をコントロールすることを特徴とする単原子層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項2】 カーボンロッドにレーザーを照射する、単原子層カーボンナノチューブのレーザー蒸発法による製造方法において、カーボンロッド中の触媒金属種とカーボンナノチューブの径の相関関係に基づき、該触媒金属種を変えることにより、該ナノチューブの径をコントロールすることを特徴とする単原子層カーボンナノチューブの製造方法。

【請求項3】 請求項1又は2のいずれかに記載の製造方法で得られた単原子層カーボンナノチューブ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、カーボンナノチューブの製造方法に係わるものである。本発明の製造方法は、雰囲気温度又はカーボンロッド中の金属触媒種を変えることで、単原子層のカーボンナノチューブの繊維径をコントロールできる点が最大の特徴であり、繊維径が制御された単原子層のカーボンナノチューブとして、エレクトロニクス分野等で適切に使用される。

【0002】

【従来の技術】 カーボンナノチューブは1991年に発見され(Nature, 354, (1991) 56)以来、1次元ワイヤ、触媒などの種々の潜在的な応用が期待される新しい材料として期待されている。数個以上の円筒状黒鉛層が同心円状に形成された通常のカーボンナノチューブは、円筒の大きさが一定ではなく、電気特性や化学特性に大きなばらつきがあった。そこで、チューブの形状が単層に制御された単原子層カーボンナノチューブの製造方法が特開平7-197325号公報で提案されている。具体的には、アーク放電法によるカーボンナノチューブの製造方法において、放電電極の一方に炭素を、他方の電極に金属(Fe, Co, Ni等の遷移金属)と炭素の混合物を用い、原料ガスに炭化水素を用いることにより、単原子層カーボンナノチューブが製造されている。

【0003】 最近になり、Smalleyらのグループが、アーク放電法ではなく、レーザー蒸発法で、高収率で単原子層カーボンナノチューブを製造している。具体的には、触媒金属としてNi/C=1/1の入った(各1.2wt%)カーボンロッドを使い、電気炉内ダブルレーザー蒸発法で、ロープ状単原子層カーボンナノチューブを非常に高い収率で得ている(A. Thess et al., Science 273 (1996) 4

83)。しかしながら、単原子層カーボンナノチューブの収率は向上しても、単原子層のカーボンナノチューブの径をコントロールすることはできなかった。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 そこで、本発明者は、上記の課題を解決すべく観察検討した結果、カーボンナノチューブのレーザー蒸発法による製造方法において、非照射部のカーボンロッドの雰囲気温度又は触媒金属種が、単原子層カーボンナノチューブの径と相関関係を有することを見出、かかる関係に基づき、雰囲気温度又は触媒金属種を変えることにより、単原子層カーボンナノチューブの径をコントロールすることができることを見出しました。

【0005】

【課題を解決するための手段】 即ち、本発明は、カーボンロッドにレーザーを照射する単原子層カーボンナノチューブのレーザー蒸発法による製造方法において、非照射部のカーボンロッドの雰囲気温度とカーボンナノチューブの径の相関関係に基づき、該雰囲気温度を変えることにより、該ナノチューブの径をコントロールすることを特徴とする単原子層カーボンナノチューブの製造方法、あるいは、カーボンロッド中の触媒金属種とカーボンナノチューブの径の相関関係に基づき、該触媒金属種を変えることにより、該ナノチューブの径をコントロールすることを特徴とする単原子層カーボンナノチューブの製造方法、及び上記いずれかの方法で製造された単原子層カーボンナノチューブに存する。

【0006】 以下、本発明をより詳細に説明する。本発明の最大の特徴は、カーボンナノチューブのレーザー蒸発法による製造方法において、非照射部のカーボンロッドの雰囲気温度あるいはカーボンロッド中の触媒金属種を変えることにより、単原子層カーボンナノチューブの繊維径をコントロールする点にある。

【0007】 具体的には、カーボンナノチューブのレーザー蒸発法による製造方法において、非照射部のカーボンロッドの雰囲気温度を下げるか、あるいは、カーボンロッド中の触媒金属を例えばNi/C=0からRh/Pdに変えることにより、単原子層カーボンナノチューブの繊維径を小さくすることができる。本発明の製造方法は、上記2つのパラメーターの組み合わせで、単原子層カーボンナノチューブの繊維径を自由にコントロールできる画期的な製造方法である。

【0008】 図1に本発明の製造装置の概略図を示す。本装置は、1:電気炉、2:カーボンロッド、3:Nd-YAGレーザー-532nm、4:Arガス導入部、5:真空ポンプ排気部、6:石英管、7:真空チャンバー、8:圧力計、9:バルブ、10:レンズから構成されている。本発明で使用する不活性ガスとしては、Arが効果的であるが、これらのガス以外にも、He、N₂、Xe、Kr、Rnなどのガスを用いることができ

る。圧力は、100~2500 Torr が好ましい。特に Ar の場合は、200~600 Torr が最適であり、He 等の低分子量ガスの場合は、圧力を高くすることにより、収率を維持することができる。

【0009】本発明で使用するレーザーは、特に限定するものではないが、波長が 1.1 μm~2.50 nm 範囲のレーザーであれば良く、Nd-YAG、CO₂、エキシマレーザー等が好適に使用される。エネルギー密度は、1.00~2.000 mJ/cm² が好適である。レーザー照射は連続でも製造できないわけではないが、パルス発振させた方が収率の点が好ましい。これは連続照射した場合には、成長中のナノチューブにレーザーが照射され破壊されるためと推定される。

【0010】本発明で使用するカーボンロッドは、炭素と触媒金属からなる。カーボンロッドは常法によって製造でき、例えばグラファイトパウダー等の市販の炭素粉と触媒金属を、グラファイトセメントやフェノール樹脂のようなバインダーと共に焼成することによって得ることができる。

【0011】カーボンロッド中の触媒金属としては、Ni、Co、Rh、Pd が好ましく、特に限定するものではないが、Ni と Co と、Rh: Pd を混ぜたものや、Ni、Co、Rh を単独で添加したもののが好適に使用される。触媒金属を混ぜ合わせて使用する場合、混合比率としては、特に限定するものではないが、収率の観点からは 1:1 が好ましい。もちろん所望のチューブ径を得るために 1:1 以外の割合にすることは充分考えられる。なお Pd 単独では、単原子層カーボンナノチューブは生成しないので、Rh と適当な割合に混ぜて使用することが好ましい。触媒金属の添加量は、各々 0.05~2.0 atomic % が好ましい。

【0012】雰囲気温度は、好ましくは、600~1500°C であり、更に好ましくは、100~1300°C である。600°C 以下及び 1500°C 以上では、カーボンナノチューブの収率が極端に低下し、現実的ではない。同一金属触媒を用いた場合、非照射部のカーボンロッドの雰囲気温度が低いほど、単原子層カーボンナノチューブの繊維径は小さくなる。ここで非照射部とするのは、照射部だけレーザー光の影響で温度が平衡に達しないからである。また、同一温度で生成させた場合、カーボンロッド中の触媒金属種を Ni、Ni/Co、Co、Rh、Rh/Pd と変えると、その順に繊維径は小さくなることを見出した。

【0013】したがって、原子量の大きな触媒金属を用いるか、雰囲気温度を低くすることにより、単原子層カーボンナノチューブの繊維径を小さくすることができる。つまり、触媒金属種と雰囲気温度を変えることで、単原子層カーボンナノチューブのチューブ径をコントロールできるわけである。本発明の製造方法は、上記 2 つのパラメーターの組み合わせで、単原子層カーボンナノ

チューブの繊維径を自由にコントロールできる画期的な製造方法であり、本発明の製造方法で得られた繊維径の制御された単原子層カーボンナノチューブは、エレクトロニクス分野等で好適に使用される。

【0014】

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明は、その要旨を越えない限り、下記実施例により限定されるものではない。

【実施例 1】図 1 に装置の概略図を示す。グラファイト粉（（株）ニラコ製）及び、Ni/Co の金属粉（（株）ニラコ製）を混ぜ、グラファイトセメント（（株）ニラコ製）で固め、Ar 雰囲気で 1200°C にて熱処理を施して、カーボンロッドを作製した。電気炉中ににおいて石英管内に、Ni/Co = 1:1 で、各 0.6 atomic % 添加したカーボンロッド（6 mm φ × 30 mm）を置き、Ar 雰囲気とし、圧力を 500 Torr、雰囲気温度を 1200°C とした。波長 532 nm、エネルギー密度 3.000 mJ/cm²、1.0 Hz のパルス光の Nd-YAG レーザー（スペクトラフィジック社製）をこのカーボンロッドにスポットサイズ 6 mm φ で照射した。管壁に付着した生成物を回収し、TEM 觀察及び励起光度計でアルゴンイオンレーザー 488 nm、20 mW を用いラマン分光測定を実施した。図 3 にて TEM 写真を示すが、単原子層カーボンナノチューブであることがわかる。ラマンスペクトルを図 2 に示す。チューブの径を、Science vol. 275 1997 p 187~191 記載のラマン分光法によるピーク位置とチューブ径の関係により見積り、チューブ径の分布が 1.1 Å 付近にピークをもつことがわかった。

【0015】（実施例 2）雰囲気温度を 1000°C とした以外は、実施例 1 と同様にして、実験を行ったところ、チューブ径の分布は、1.0 Å 付近がピークであることがわかった。

（実施例 3）雰囲気温度を 1300°C とした以外は、実施例 1 と同様にして、実験を行ったところ、チューブ径の分布は、1.3~1.5 Å 付近がピークであることがわかった。

【0016】（実施例 4）触媒金属を Rh/Pd = 1:1 とし、各 1.2 atomic % 添加したカーボンロッドを用い、雰囲気温度を 1000°C とした以外は、実施例 1 と同様にして、実験を行ったところ、チューブ径の分布は、7~8 Å 付近がピークであることがわかった。

（実施例 5）雰囲気温度を 1200°C とした以外は、実施例 4 と同様にして、実験を行ったところ、チューブ径の分布は、9~10 Å 付近がピークであることがわかった。

【0017】（実施例 6）雰囲気温度を 1300°C とした以外は、実施例 4 と同様にして、実験を行ったところ、チューブ径の分布は、11~12 Å 付近がピークであることがわかった。

(実施例7) 脱媒金属をRhとし、0.6 atomic %添加したカーボンロッドを用い、雰囲気温度を120°Cとした以外は、実施例1と同様にして、実験を行ったところ、チューブ径の分布は、1.0、5.5附近がピークであることがわかった。

【0018】

【発明の効果】上記特徴を有する本発明の製造方法で得られた繊維径の制御された単原子層カーボンナノチューブは、エレクトロニクス分野等で好適に使用され、多大な工業的利益を提供するものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明で用いたカーボンナノチューブの

製造装置を説明する図である。

【図2】図2は本発明の実施例の結果得られたカーボンナノチューブの直径の測定に用いたラマン分光の測定結

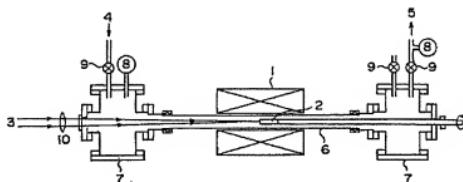
果を示す図である。

【図3】図3は実施例1で得られた単原子層カーボンナノチューブの纖維形状を示す顕微鏡写真(TEM写真)である。

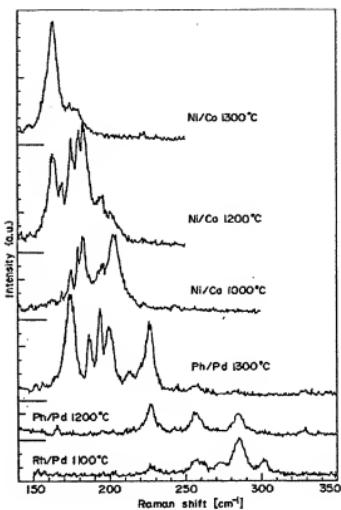
【符号の説明】

1	電気炉
2	カーボンロッド
3	Nd-YAGレーザー
4	Arガス導入部
5	真空ポンプ排気部
6	石英管
7	真空チャンバー
8	圧力計
9	バルブ
10	レンズ

【図1】



【図2】



【図3】

図面代用写真

